
	<h2>SI5441DC-T1-E3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI5441DC-T1-E3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 3.9A 1206-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI5441DC-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 240302 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI5441DC-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 3.9A 1206-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	240302 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	55 mOhm @ 3.9A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 3.9A (Ta) 1.3W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.9A (Ta)

SI5441DC-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5441DC-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5441DC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5441DC-T1-E3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI5441DC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 3.9A 1206-8</p>	 <p><b>SI5442DU-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 25A PPAK CHIPFET</p>	 <p><b>SI5441DC-T1</b> VISHAY SI5441DC-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI5441BDC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 4.4A 1206-8</p>
 <p><b>SI5443DC</b> VISHAY SI5443DC VISHAY</p>	 <p><b>SI5442DU-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 25A PPAK CHIPFET</p>	 <p><b>SI5441DC</b> Vishay SI5441DC Vishay</p>	 <p><b>SI5441BDC-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 4.4A 1206-8</p>

### SI5441DC-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI5441DC-T1-E3 Datenblatt	SI5441DC-T1-E3-Datenblätter	SI5441DC-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI5441DC-T1-E3
SI5441DC-T1-E3 Electronic	SI5441DC-T1-E3-Komponenten	SI5441DC-T1-E3-Verteiler	SI5441DC-T1-E3-Bild	SI5441DC-T1-E3 Aktie	SI5441DC-T1-E3 Inventar
SI5441DC-T1-E3 Preis	SI5441DC-T1-E3 Hersteller	SI5441DC-T1-E3 garantiert	SI5441DC-T1-E3 RFQ	SI5441DC-T1-E3 Online bestellen	

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited